

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 504НТ3АСВК, 504НТ3БСВК, 504НТ3ВСВК, 504НТ3АС1ВК, 504НТ3БС1ВК, 504НТ3ВС1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.179 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена _____
Дата

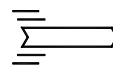
Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ 504НТ3АСВК,
504НТ3БСВК, 504НТ3ВСВК,
504НТ3АС1ВК, 504НТ3БС1ВК, 504НТ3ВС1ВК

Код ОКП : 6331320445 – 504НТ3АСВК 6331320455 – 504НТ3АС1ВК
6331320465 – 504НТ3БСВК 6331320475 – 504НТ3БС1ВК
6331320485 – 504НТ3ВСВК 6331320495 – 504НТ3ВС1ВК

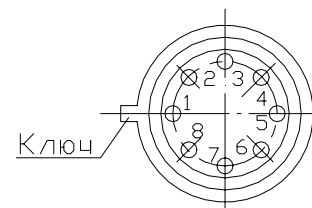
ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431130.020 ЭТ

Микросхемы интегральные 504НТ3АСВК, 504НТ3БСВК, 504НТ3ВСВК, 504НТ3АС1ВК, 504НТ3БС1ВК, 504НТ3ВС1ВК – сильноточная согласованная пара полевых транзисторов.

Шифр кода маркировки микросхем 504НТ3АСВК, 504НТ3АС1ВК – 504НТ3А, 504НТ3БСВК, 504НТ3БС1ВК – 504НТ3Б, 504НТ3ВСВК, 504НТ3ВС1ВК – 504НТ3В в соответствии с АЕЯР.431410.179 ТУ.

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 1,5 г.

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение вывода
1	Сток 1
2	Исток 1
3	Корпус
4	Исток 2
5	Сток 2
6	Затвор 2
7	Свободный
8	Затвор 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре (25 ± 5)° C							
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а					
		504НТ3АСВК 504НТ3АС1ВК		504НТ3БСВК 504НТ3БС1ВК		504НТ3ВСВК 504НТ3ВС1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Начальный ток стока, мА, при: U _{СИ} = -10 В; U _{ЗИ} = 0 В	I _{с.нач.}	1,5	7,5	5	15	7,5	20
Крутизна характеристики, мА/В, при: U _{СИ} = -10 В; U _{ЗИ} = 0 В	S	1,5	-	3	-	5	-
Ток утечки затвора, нА, при: U _{ЗИ} = 5 В;	I _{з.ут.}	-	2	-	2	-	2
Коэффициент шума, дБ, при: 1/F = 135 ± 45 Гц; U _{СИ} = -5 В; U _{ЗИ} = 0 В; R _Г = 1 МОм; F = 1 кГц	Кш	-	2	-	2	-	2
Разность напряжений затвористок, мВ, при: U _{СЗ} = -5 В; R _Н = 10 кОм; I _с = 100 мкА	U _{ЗИ1} - U _{ЗИ2}	-	30	-	30	-	30
Содержание драгоценных металлов в 1000 штук микросхем: - золото Цветных металлов не содержится.							

НАДЕЖНОСТЬ Минимальная наработка (Т_{нм}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченном режиме при напряжениях и токах, не превышающих 60% предельных значений, -150000ч Гамма-процентный ресурс (Т_{ру}) микросхем при у=95% 150000 ч Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т_{см}) при их хранении: - в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет; - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет; - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет. Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.179 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.
